

Физика и техника полупроводников, 2015, том 49, выпуск 10

Неэлектронные свойства полупроводников (атомная структура, диффузия)

Зарецкая Е.П., Гременок В.Ф., Семченко А.В., Сидский В.В., Юшканес Р.Л.

Структурные свойства пленок ZnO : Al, полученных золь-гель методом

1297

Maksimov S., Maksimov K., Sukhov N., Lovygin M.

New mechanism of structuring associated with the quasi-merohedral twinning by an example of $\text{Ca}_{1-x}\text{La}_x\text{F}_{2+x}$ ordered solid solutions

1304

Электронные свойства полупроводников

Ормонт М.А.

Смена механизма переноса в области перехода от сублинейности к суперлинейности частотной зависимости проводимости неупорядоченных полупроводников

1314

Боднарь И.В., Труханов С.В., Баругу Т.Г.

Магнитные и электрические свойства монокристаллов $\text{Fe}_{0.5}\text{Ag}_{0.1}\text{In}_{2.3}\text{S}_{4.4}$

1320

Камилов Т.С., Аксенова Л.Л., Шарипов Б.З., Эрнст И.В.

Исследование токовых неустойчивостей в гетеропереходах $\text{Mn}_4\text{Si}_7\text{-Si<Mn>-Mn}_4\text{Si}_7$ и $\text{Mn}_4\text{Si}_7\text{-Si<Mn>-M}$

1325

Малин Т.В., Гишинский А.М., Мансуров В.Г., Протасов Д.Ю., Кожухов А.С., Якимов Е.Б., Журавлев К.С.

Увеличение диффузионной длины неосновных носителей заряда в твердых растворах $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N}$ ($x=0-0.1$), полученных методом аммиачной молекулярно-лучевой эпитаксии

1329

Реутов В.Ф., Дмитриев С.Н., Сохацкий А.С., Залужный А.Г.

Влияние ионизационных потерь энергии высокоэнергетических ионов висмута на развитие гелиевых блистеров в кремнии

1335

Вейнгер А.И., Забродский А.Г., Макарова Т.Л., Тиснек Т.В., Голощапов С.И., Семенихин П.В.

Обнаружение примесной диамагнитной восприимчивости и ее поведение в n-Ge : As вблизи фазового перехода изолятор-металл

1339

Немов С.А., Благих Н.М., Аллаххах А., Иванова Л.Д.

Анизотропный смешанный механизм рассеяния дырок в кристаллах $\text{Sb}_2\text{Te}_{3-x}\text{Se}_x$ ($0 \leq x \leq 0.1$) по данным эффектов Нернста-Эттингсгаузена и Зеебека

1346

Поверхность, границы раздела, тонкие пленки

Брудный В.Н., Саркисов С.Ю., Кособуцкий А.В.

Уровень зарядовой нейтральности и электронные свойства межфазных границ в слоистом полупроводнике ν арепсилон-GaSe

1351

Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления

Покутний С.И., Кульчин Ю.Н., Дзюба В.П.

Энергии связи экситона из пространственно разделенных электрона и дырки в диэлектрических квантовых точках

1355

Наумова О.В., Зайцева Э.Г., Фомин Б.И., Ильницкий М.А., Попов В.П.

Зависимость подвижности электронов в режиме обогащения от их плотности в полностью обедняемых пленках кремний-на-изоляторе

1360

Кацаба А.В., Федянин В.В., Амброзевич С.А., Витухновский А.Г., Соколикова М.С., Васильев Р.Б.

Плотность поверхностных состояний в коллоидных нанопластинах CdSe

1367

Крылов П.Н., Закирова Р.М., Князев И.А., Костенков Н.В., Романов Э.А., Федотова И.В.

Структура и оптические спектры пропускания напыленных при низких температурах нанокompозитных пленок ZnS-SiO_2

1371

Бахадырханов М.К., Исамов С.Б., Илиев Х.М., Камалов Х.У.

Аномально большое время жизни дырок в кремнии с нанокластерами атомов марганца

1376

Соболев М.М., Буяло М.С., Неведомский В.Н., Задиранов Ю.М., Золотарева Р.В., Васильев А.П., Устинов В.М., Портной Е.Л. Эмиссионные спектры лазера на сверхрешетке квантовых точек In(Ga)As/GaAs	1379
Лебедев А.А., Белов С.В., Мынбаева М.Г., Стрельчук А.М., Богданова Е.В., Макаров Ю.Н., Усиков А.С., Курин С.Ю., Бараш И.С., Роенков А.Д., Козловский В.В. Радиационная стойкость диодов Шоттки на основе n-GaN	1386
Маслов А.Ю., Прошина О.В. Полярная масса носителей в полупроводниковых квантовых ямах	1389
Аморфные, стеклообразные, органические полупроводники	
Никитенко В.Р., Саунина А.Ю. Вольт-амперные характеристики слоев неупорядоченных органических материалов в режиме ограничения объемным зарядом на основе концепции транспортного уровня	1393
Теруков Е.И., Серегин П.П., Марченко А.В., Жилина Д.В., Бобохужаев К.У. Рентгенофлуоресцентный анализ стекол $Ge_{1-x}Se_x$, $As_{1-x}Se_x$ и $Ge_{1-x-y}As_ySe_x$ с использованием электронного возбуждения	1397
Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники	
Бобков А.А., Максимов А.И., Мошников В.А., Сомов П.А., Теруков Е.И. Наноструктурированные материалы на основе оксида цинка для гетероструктурных солнечных элементов	1402
Физика полупроводниковых приборов	
Wu Yi-Chen, Tsai Jung-Hui, Chiang Te-Kuang, Wang Fu-Min Comparative Investigation of InGaP/GaAs/GaAsBi and InGaP/GaAs Heterojunction Bipolar Transistors	1407
Шенгуров В.Г., Чалков В.Ю., Денисов С.А., Алябина Н.А., Гусейнов Д.В., Трушин В.Н., Горшков А.П., Волкова Н.С., Иванова М.М., Круглов А.В., Филатов Д.О. Фотодетекторы на базе гетероструктур Ge/Si(001), выращенных методом горячей проволоки	1411
Грудинкин С.А., Донцов А.А., Феоктистов Н.А., Баранов М.А., Богданов К.В., Аверкиев Н.С., Голубев В.Г. Моды шепчущей галереи в сферическом микрорезонаторе с фотолюминесцентной оболочкой	1415
Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур	
Мукашев Б.Н., Бетекбаев А.А., Калыгулов Д.А., Павлов А.А., Скаков Д.М. Исследования процессов получения кремния и разработка технологий изготовления солнечных элементов	1421
Берт Н.А., Бондарев А.Д., Золотарев В.В., Кириленко Д.А., Лубянский Я.В., Лютецкий А.В., Слипченко С.О., Петрунов А.Н., Пихтин Н.А., Аюшева К.Р., Арсентьев И.Н., Тарасов И.С. Свойства нитрида алюминия, полученного методом реактивного ионно-плазменного распыления	1429
Егоров А.Ю., Карачинский Л.Я., Новиков И.И., Бабичев А.В., Березовская Т.Н., Неведомский В.Н. Метаморфные брэгговские отражатели спектрального диапазона 1440-1600 нм: эпитаксия, формирование и зарастивание мезаструктур	